

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0599U000266

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-05-1999

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павлик Богдан Васильович

2. Pavlyk Bogdan Vasyl'ovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 02-06-1999

Спеціальність за освітою: 7.070102

Місце роботи здобувача: Львівський національний університет ім. Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070986

Місцезнаходження: 79000, Україна, Львів, вул.Університетська,1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35.051.09

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет ім. Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070986

Місцезнаходження: 79000, Україна, Львів, вул.Університетська,1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31, 29.19.33

Тема дисертації:

1. Радіаційно- і термостимульовані процеси агрегатизації дефектів та виділення компонент діелектричних та напівпровідникових кристалів.

2. Radiation- and thermo-stimulated processes of defects aggregation and emission of dielectric and semiconductor crystals components.

Реферат:

1. Об'єкт дослідження: Діелектричні та напівпровідникові кристали. Мета дослідження: Встановлення закономірностей процесів агрегатизації радіаційних дефектів та виділення компонент досліджуваних сполук. Методи дослідження: Оптична спектроскопія, мас-спектрометрія, мікроскопія, емісійно-модуляційна спектроскопія. Теоретичні і практичні результати і новизна: Запропоновано модель радіолізу водневовмісних діелектричних кристалів. Встановлені закономірності і механізм виділення компонент сполук. Ступінь впровадження: Результати впроваджені у виробництво запам'ятовуючих електронно-променевих трубок. Сфера впровадження: Електронне приладобудування. Теорія процесу радіолізу кристалів.

2. Object of investigations: Dielectric and semiconductor crystals. Aim of investigations: Study of regularities of radiation defects aggregation processes and eduction of investigated compound components. Methods: Optical

spectroscopy, mass spectroscopy, microscopy, capacity-modulation spectroscopy. Results: The model of radiolysis of hydrogenous dielectric crystals was suggested. The regularity and education mechanism of compound components was ascertained. Inculcation: The results are used in the production of electron-beam memory tubes. Application: The production of electron devices. Theory of crystals radiolysis processes.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стахіра Й.М.
2. Стахіра Й.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литовченко В.Г.
2. Литовченко В.Г.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Блонський І.В.

2. Блонський І.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Матковський А.О.

2. Матковський А.О.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. **Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Вакарчук І.О.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Вакарчук І.О.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.